

En enkel BJT - transistor brukt som forsterker - Hvor stor blir forsterkningen ? Vi ser på Småsignalmodeller

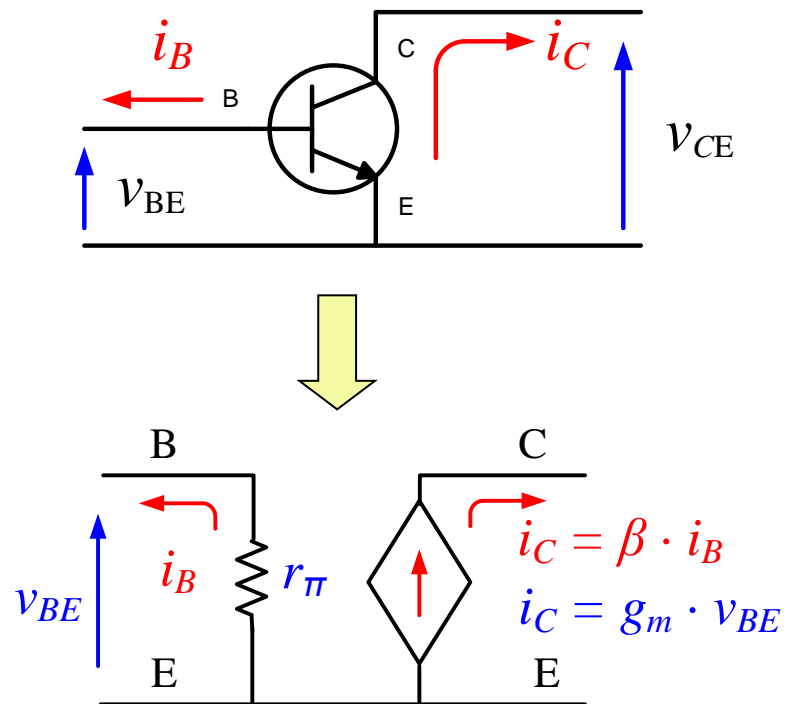
Vi har sett hvordan vi vha. en emittermotstand kan stabilisere forsterkerens arbeidspunkt - Alle betraktninger så langt er gjort med en DC – modell av forsterkeren. (En statisk beregningsmodell)

- Men hvordan virker forsterkeren for små signaler ?

Vi erstatter det vanlige transistorsymbolet med en småsignalmodell – hvor signalstrømmer og spenninger angis med små bokstaver

Mellom Base og Emmitter "ser" signalet en "dynamisk" motstand r_{π} – mellom Emmitter og Collector finner vi en strømgenerator som leverer signalstrømmen i_C . Denne strømmen bestemmes av transistorens transkonduktans g_m - ("steilhet")

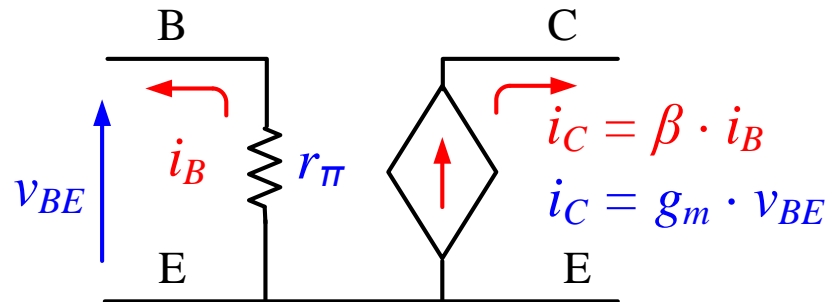
r_{π} og g_m kalles småsignalparametere



En enkel BJT - transistor brukt som forsterker - Hvor stor blir forsterkningen ? Vi ser på Småsignalmodeller

Vi kan betrakte transistoren både som en strømstyrt og en spenningsstyrt komponent.

Signalstrømmen på kollektor - i_C
- kan beregnes hvis vi kjenner i_B
eller v_{BE} .



$$i_B = \frac{v_{BE}}{r_\pi} \quad i_C = \beta \cdot i_B = g_m \cdot v_{BE}$$

Når signalkomponentene v_{BE} , i_B og i_C er små – er disse likningene lineære

Vi må finne generelle uttrykk for småsignalparametrene g_m og r_π

$$\text{Steilhet } g_m = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}} \quad r_\pi = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$$

Småsignalparametere : g_m og r_{π}

Transkonduktans - steilhet g_m

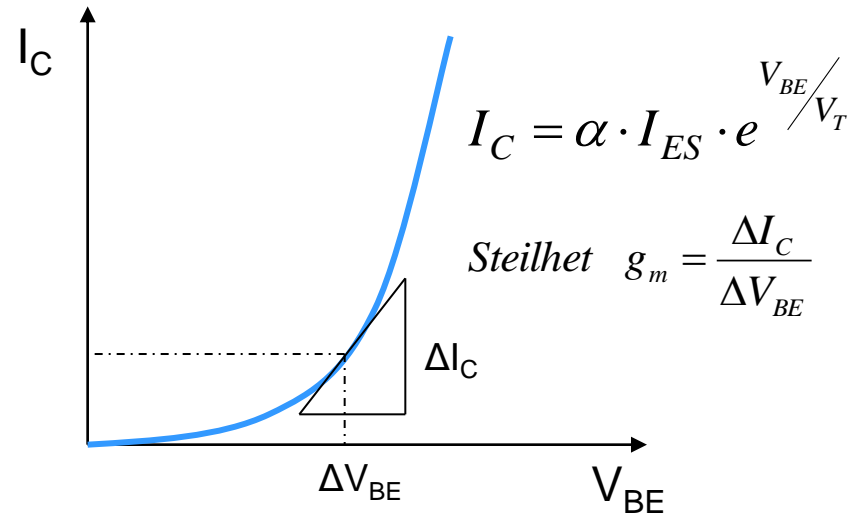
(benevning Siemens)

$$\text{Emitterstrømmen } I_E = I_S \cdot e^{V_D/V_T}$$

hvor $V_D = V_{BE}$ og $V_T = 25 \text{ mV}$

(diodelikningen)

$$I_C = \alpha \cdot I_E \quad \alpha \cong 1$$



Steilheten g_m er gitt av tangenten til kurven for I_C . Deriverer I_C mhp. V_{BE}

$$g_m = \frac{d(I_C)}{dV_{BE}} = \alpha \cdot I_{ES} \cdot e^{V_{BE}/V_T} \cdot \frac{1}{V_T} = I_C \cdot \frac{1}{V_T} = \frac{I_C}{V_T}$$

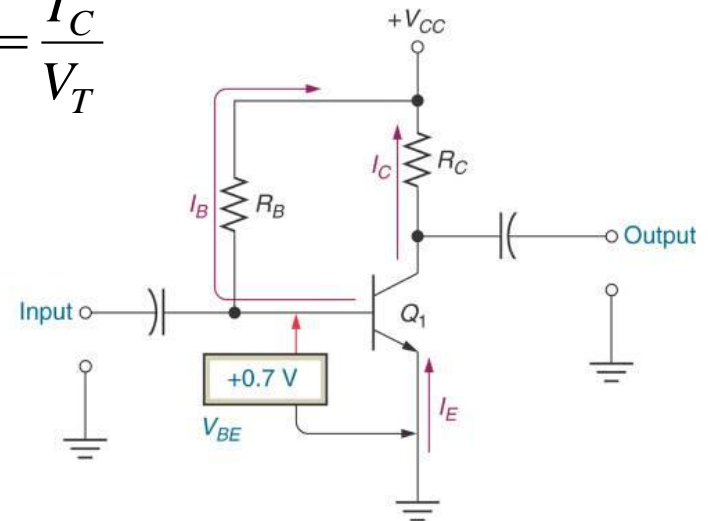
$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

Eksempel : Forsterkeren settes opp

med $I_C = 2 \text{ mA}$

- som gir

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 80 \text{ mS}$$



Småsignalparametere : g_m og r_π

Dynamisk inngangsmotstand r_π

$$r_\pi = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

en liten endring i I_B gir stor endring i I_C

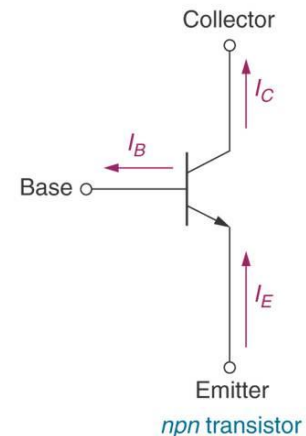
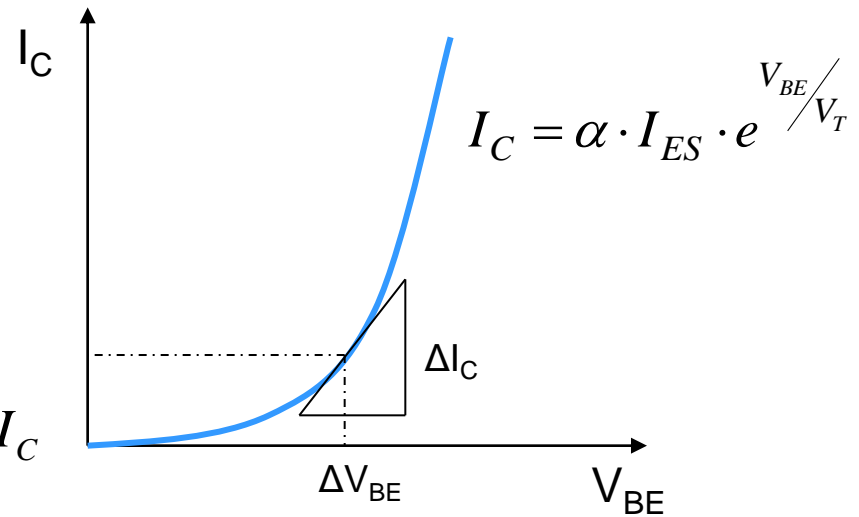
$$1) \Delta I_B = \frac{\Delta I_C}{\beta} \quad 2) g_m = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}} \rightarrow \Delta I_C = g_m \cdot \Delta V_{BE}$$

Forholdet mellom ΔV_{BE} og ΔI_B kalles den dynamiske inngangsresistansen r_π

Kombinerer likning 1) og 2)

$$\Delta I_B = \frac{g_m \cdot \Delta V_{BE}}{\beta}$$

$$r_\pi = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_C}$$



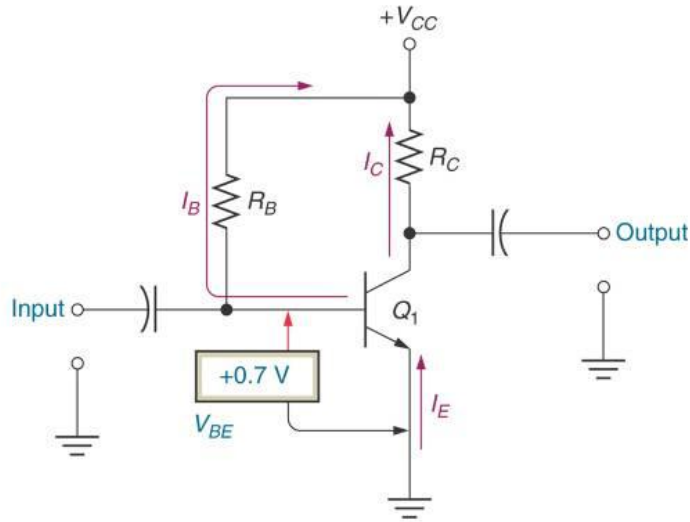
$$I_C = I_E - I_B \rightarrow I_C = \alpha \cdot I_E$$

Transistorforsterker – småsignalparametere

Vi beregning spenningsforsterkningen A_V

$$\text{Steilhet } g_m = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$



$$1) \quad \Delta I_C = g_m \cdot \Delta V_{BE}$$

$$2) \quad V_{RC} = I_C \cdot R_C \quad (\text{ohms lov})$$

Setter inn 1) i 2) som gir

$$\Delta V_{RC} = g_m \cdot \Delta V_{BE} \cdot R_C$$

Forsterningen A_V er definert som $A_V = \frac{V_{Output}}{V_{Input}} = \frac{\Delta V_{RC}}{\Delta V_{BE}} = g_m \cdot R_C$

$$A_V = g_m \cdot R_C$$

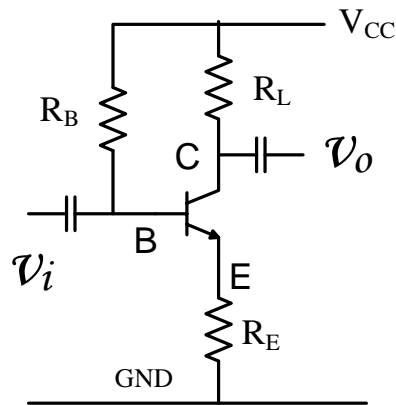
Eksempel: Gitt $V_{CC}=10\text{volt}$ Setter $V_C=5\text{volt}$ Vi bestemmer at $I_C = 2\text{mA}$

$$\text{Beregner } R_C = \frac{V_{RC}}{I_C} = \frac{5\text{V}}{2\text{mA}} = 2,5 \text{ k}\Omega \quad g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2\text{mA}}{25\text{mV}} = 80\text{mS}$$

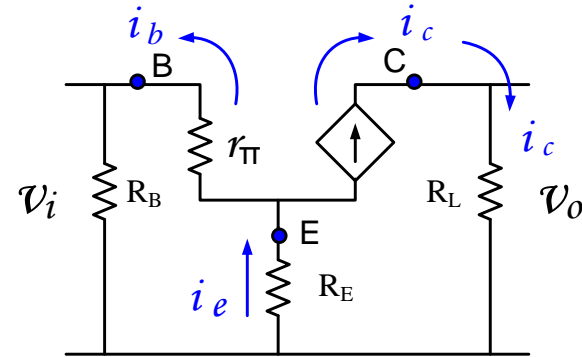
$$\text{Forsterkningen } A_V = 80 \text{ mS} \cdot 2,5 \text{ k}\Omega = 200$$

Småsignalmodeller Forsterker med emittermotstand

DC-modell



småsignalmodell



$$v_i = v_{be} + v_E \quad (1) \quad v_{be} = i_b \cdot r_\pi \quad (2)$$

$$v_E = (i_b + i_c) \cdot R_E = (i_b + i_b \cdot \beta) \cdot R_E = i_b (\beta + 1) \cdot R_E \quad (3)$$

Setter (2) og (3) inn i (1)

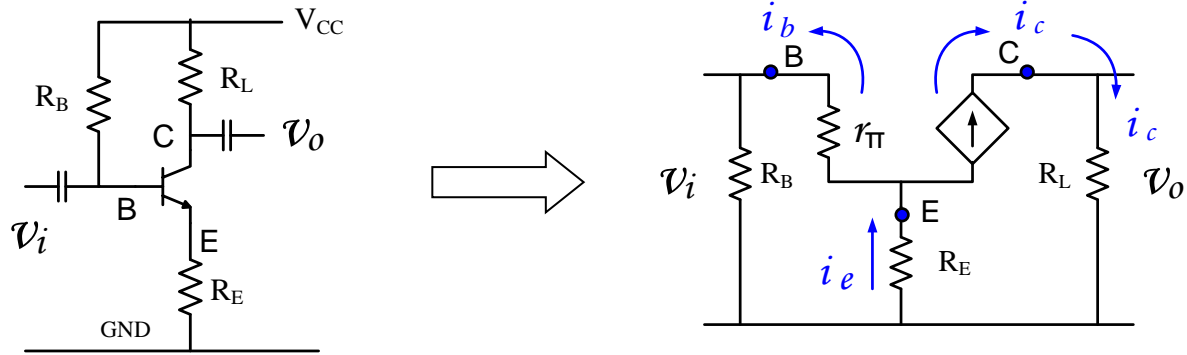
$$v_i = i_b \cdot r_\pi + i_b (\beta + 1) \cdot R_E \rightarrow i_b = \frac{v_i}{r_\pi + (\beta + 1) \cdot R_E} \quad (4)$$

$$v_o = -i_c \cdot R_L = -i_b \cdot \beta \cdot R_L \rightarrow (4) \rightarrow = -\frac{\beta \cdot v_i}{r_\pi + (\beta + 1) \cdot R_E} \cdot R_L \quad A_v = -\frac{v_o}{v_i}$$

Bemerk (-) Forsterkeren inverterer signalet.

Positivt signal-sving på basen kommer ut som negativt sving på kollektor

Småsignalmodeller Forsterker med emittermotstand (2)



$$v_i = i_b \cdot r_\pi + i_b (\beta + 1) \cdot R_E \rightarrow i_b = \frac{v_i}{r_\pi + (\beta + 1) \cdot R_E} \quad (4)$$

$$v_o = -i_c \cdot R_L = -i_b \cdot \beta \cdot R_L \rightarrow (4) \rightarrow = -\frac{\beta \cdot v_i}{r_\pi + (\beta + 1) \cdot R_E} \cdot R_L$$

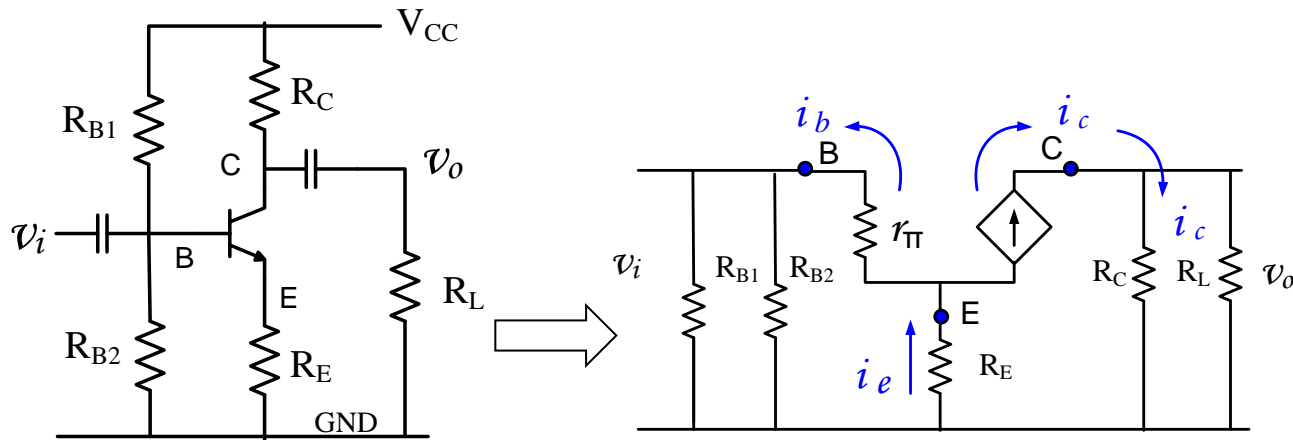
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta \cdot R_L}{r_\pi + (\beta + 1) \cdot R_E} \quad \text{setter inn } r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

$$A_v = -\frac{g_m \cdot R_L}{1 + (1 + \frac{1}{\beta}) \cdot g_m \cdot R_E} \approx -\frac{g_m \cdot R_L}{1 + g_m \cdot R_E} \approx -\frac{R_L}{R_E} \Rightarrow$$

$$A_v \approx -\frac{R_L}{R_E}$$

Ser på "input resistance" til transistoren $r_{inn} = \frac{v_i}{i_b} \rightarrow \text{fra (4)} \rightarrow \underline{\underline{r_\pi + (\beta + 1)R_E}}$

Småsignalmodeller Forsterker med emittermotstand (3)



Forsterkning

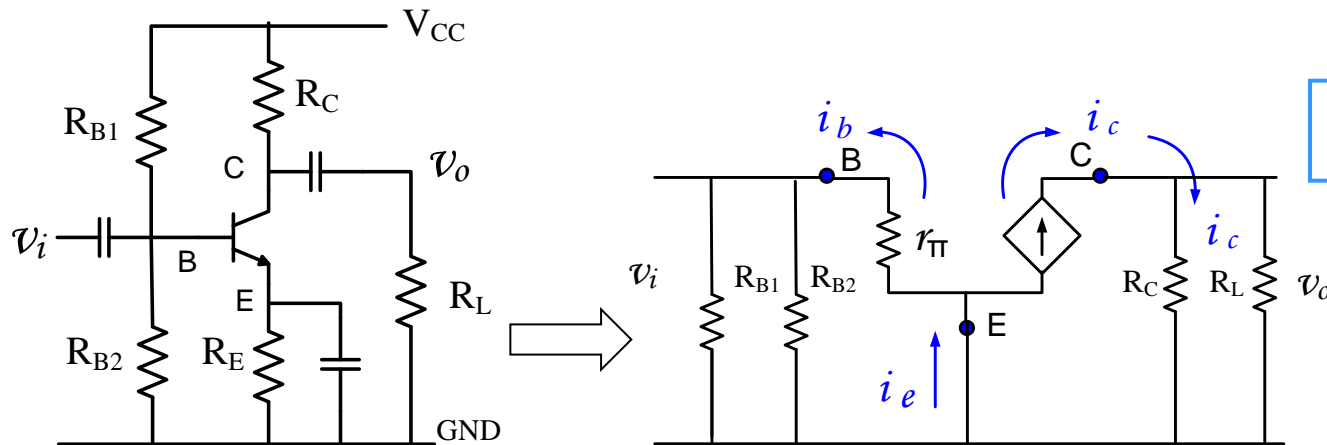
$$A_v \approx -\frac{R_C \parallel R_L}{R_E}$$

Signalkilden ser inn mot en motstand

$$R = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{inn} \text{ hvor}$$

$$r_{inn} = r_{\pi} + (\beta + 1)R_E$$

Småsignalmodell Forsterker med avkoplet emittermotstand

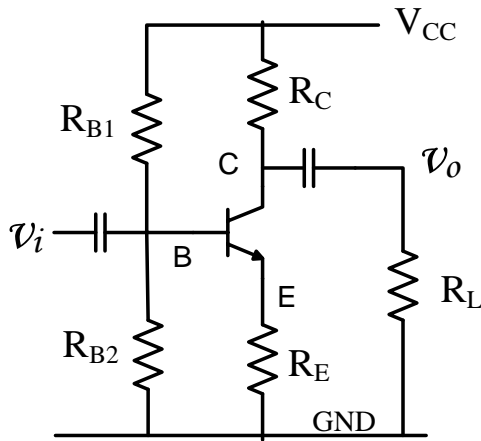


Forsterkning

$$A_V = -g_m \cdot (R_C \parallel R_L)$$

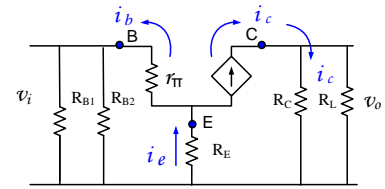
$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

Regneeksempel - Gitt en forsterker med emittermotstand



$$R_{B1} = 35 \text{ k}\Omega, R_{B2} = 15 \text{ k}\Omega, R_C = 6 \text{ k}\Omega,$$

$$R_L = 1,5 \text{ k}\Omega, R_E = 1 \text{ k}\Omega, I_C = 2 \text{ mA}, \beta = 200$$



$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 80 \text{ mS}$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{200}{80 \text{ mS}} = 2,5 \text{ k}\Omega$$

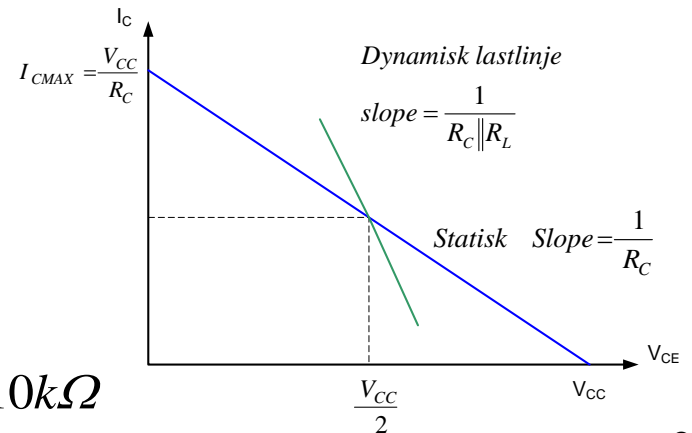
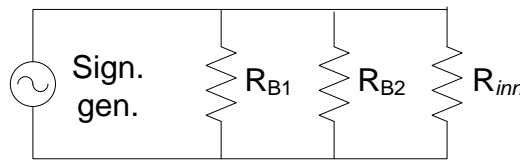
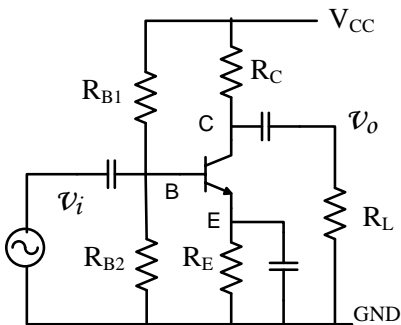
$$R_P = R_C \parallel R_L = \frac{6 \text{ k} \cdot 1,5 \text{ k}}{6 \text{ k} + 1,5 \text{ k}} = 1,2 \text{ k}$$

$$A_V = -\frac{R_P}{R_E} = \frac{1,2 \text{ k}}{1 \text{ k}} = -1,2$$

Hvis vi avkople emittermotstanden med en kondensator $A_V = -g_m \cdot R_P = 80 \text{ mS} \cdot 1,2 \text{ k} = -96$

$$R_{inn} = r_\pi + (\beta + 1)R_E = 2,5 \text{ k} + 201 \cdot 1 \text{ k} = 203,5 \text{ k}\Omega$$

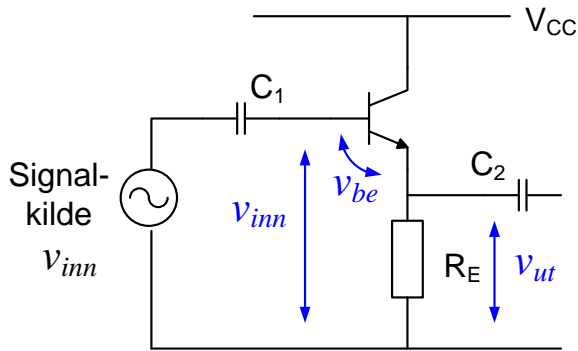
Lastlinjen endres i forhold til DC-modellen



generatore n ser inn mot $R_{INN} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel R_{inn} \cong 10 \text{ k}\Omega$

EMITTERFØLGER

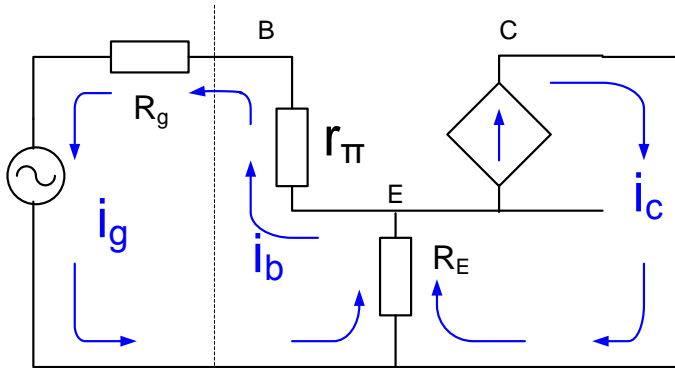
- Signalet hentes ut over emittermotstanden



Forenklet skjema – utelatt spenningsdeler på basen



Småsignalmodellen



$$\rightarrow i_b = \frac{v_{inn}}{r_{\pi} + (\beta + 1) \cdot R_E}$$

$$v_{ut} = i_e \cdot R_E = (\beta + 1) \cdot i_b \cdot R_E = \frac{(\beta + 1) \cdot R_E \cdot v_{inn}}{r_{\pi} + (\beta + 1) \cdot R_E}$$

$$A_v = \frac{v_{ut}}{v_{inn}} = \frac{(\beta + 1) \cdot R_E}{r_{\pi} + (\beta + 1) \cdot R_E} \cong 1$$

Betrakter signalspenningene $v_{inn} = v_{be} + v_{ut}$

v_{be} er liten $\rightarrow v_{inn} \approx v_{ut}$

Ser på tilkoplingen av en signalgenerator med indre motstand R_g og signal v_{inn}

Vi ser bort fra kondensatorene – de stopper DC men slipper signalet uhindret igjennom

$$i_e = (\beta + 1) \cdot i_b \rightarrow i_g = i_b \rightarrow i_e = (\beta + 1) \cdot i_g$$

Strømførsterkning

$$A_i = \frac{i_e}{i_g} = (\beta + 1) \quad \text{Effektforsterkning} \quad P = v \cdot i$$

$$v_{ut} + v_{be} = v_{inn} \rightarrow (\beta + 1) \cdot i_b \cdot R_E + i_b \cdot r_{\pi} = v_{inn}$$

Stor strømførsterkning
- Ingen spenningsforsterkning